

Photoempfänger JI 1P mit Verstärker

- Charakteristik :
- ◆ Spektralbereich 380 ... 1100 nm
 - ◆ strahlungsempfindliche Fläche 1 mm²
 - ◆ Si - PIN - Photodiode mit integriertem Strom-Spannungswandler
 - ◆ geringe Dunkeloffsetspannung und Driftparameter
 - ◆ großer Dynamikbereich
 - ◆ Modifikation (Transimpedanz, Zahl der Betriebs-
spannungen) möglich

- Applikationen :
- ◆ allgemeine lichttechnische und nichtoptische Anwendungen
 - ◆ schneller Detektor zum Nachweis kleiner Strahlungsintensitäten bei hohem Signal/Rauschverhältnis

Grenzwerte:

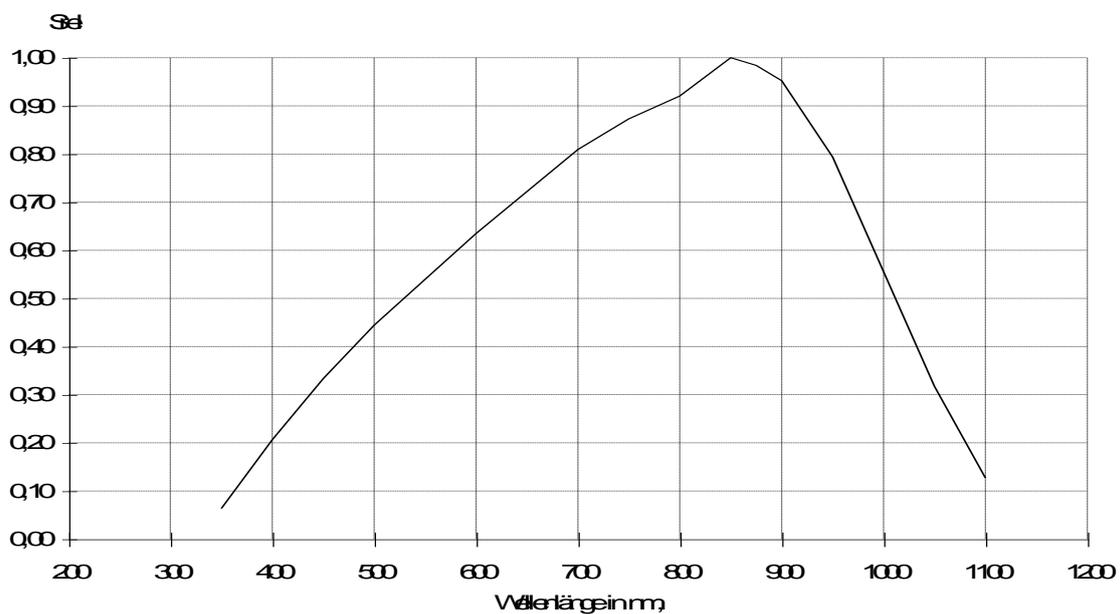
Betriebsspannung	± 18	V
Verlustleistung	180	mW
Betriebstemperaturbereich	- 25 °C ... 70	°C
Lagertemperaturbereich	- 40 °C ... 100	°C
Löttemperatur (3s)	260	°C

Technische Daten :

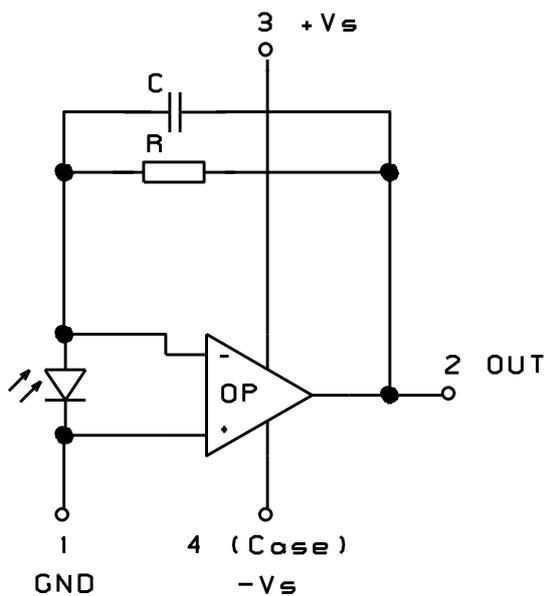
Allgemeine Meßbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: $\gamma_a = 23 \text{ °C}$, $V_{cc} = \pm 15 \text{ V}$

Parameter	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einh.
Dunkeloffsetspannung	E = 0 lx		0,5		mV
Aussteuerung			- 13		V
Rauschspannung	B = 20 kHz		0,3	0,5	mV _{rms}
Empfindlichkeit	$\lambda = 850 \text{ nm}$		5,5		V/ μ W
Transimpedanz			10		M Ω
Betriebsspannung		± 5	± 15	± 18	V
Betriebsspannungs- unterdrückung			20		μ V/V
Stromaufnahme			± 4		mA
Anstiegszeit			8		μ s
Abfallzeit			8		μ s
Bandbreite	- 3 dB		40		kHz

Relative spektrale Empfindlichkeit



Innenschaltung



Gehäuseabmessungen

